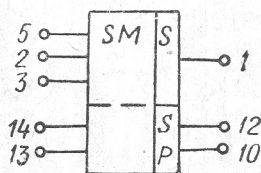


ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА



- | | |
|-----------------|------------------|
| 1 — выход E_1 | 10 — выход C_2 |
| 2 — вход A_1 | 11 — общий |
| 3 — вход B_1 | 12 — выход E_2 |
| 4 — +5 В | 13 — вход A_2 |
| 5 — вход C_0 | 14 — вход B_2 |
| 6—9 — свободные | |

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

(при температуре $25 \pm 10^\circ \text{C}$)

Напряжение источника питания	+5 В $\pm 10\%$
Выходное напряжение логического «0» Δ для микросхем:	
1ИС061А, К1ИС061А, К1ИС061В	не более 0,28 В
К1ИС061Б	не более 0,50 В
Выходное напряжение логической «1» Δ для микросхем:	
1ИС061А, К1ИС061А, К1ИС061В	не менее 2,7 В
К1ИС061Б	не менее 2,2 В
Входной ток логического «0»:	
на выводах 2, 3, 5 для микросхем	
1ИС061А, К1ИС061А	не более 6,0 мА
К1ИС061Б	не более 6,8 мА
К1ИС061В	не более 6,4 мА
на выводах 13, 14 для микросхем	
1ИС061А, К1ИС061А	не более 1,5 мА
К1ИС061Б	не более 1,7 мА
К1ИС061В	не более 1,6 мА
Входной ток логической «1» Δ :	
на выводах 2, 3, 5 для микросхем	
1ИС061А, К1ИС061А	не более 240 мкА
К1ИС061Б, К1ИС061В	не более 320 мкА

Δ Параметр надежности в течение срока сохраняемости.

ДВУХРАЗЯДНЫЙ СУММАТОР

1ИС061А	К1ИС061Б
К1ИС061А	К1ИС061В

на выходах 13, 14 для микросхем	
1ИС061А, К1ИС061А	не более 60 мкА
К1ИС061Б, К1ИС061В	не более 80 мкА
Время задержки распространения логического уровня:	
от C_0 до E_2 для микросхем	
1ИС061А, К1ИС061А	не более 60 нс
К1ИС061Б	не более 100 нс
от C_0 до C_2 для микросхем К1ИС061В	
не более 20 нс	
Нагрузочная способность:	
по выходам E_1 и E_2 для микросхем	
1ИС061А, К1ИС061А, К1ИС061Б	10
К1ИС061В	5
по выходу C_2 для микросхем	
1ИС061А, К1ИС061А, К1ИС061Б	5
К1ИС061В	3
Помехоустойчивость при максимальном числе нагрузок для микросхем 1ИС061А	
не менее 0,7 В	

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Максимальное выходное напряжение логического «0» для микросхем:	
1ИС061А, К1ИС061А, К1ИС061В	0,40 В
К1ИС061Б	0,65 В
Минимальное выходное напряжение логической «1» для микросхем:	
1ИС061А, К1ИС061А, К1ИС061В	2,4 В
К1ИС061Б	2,0 В
Выходной ток при напряжении логического «0»:	
по выходам E_1 и E_2 для микросхем	
1ИС061А, К1ИС061А, К1ИС061Б	15 мА
К1ИС061В	8 мА
по выходу C_2 для микросхем	
1ИС061А, К1ИС061А, К1ИС061Б	8,0 мА
К1ИС061В	4,8 мА
Выходной ток при напряжении логической «1»:	
по выходам E_1 , E_2 для микросхем	
1ИС061А, К1ИС061А, К1ИС061Б	0,8 мА
К1ИС061В	0,4 мА

по выходу C_2 для микросхем 1ИС061А, К1ИС061А, К1ИС061Б	0,40 мА
К1ИС061В	0,24 мА
Максимальное напряжение, которое может пода- ваться на входы	5,5 В
Максимальная статическая мощность потребления при $U_{вх} = 5,5$ В	180 мВт
Напряжение статической помехи для микросхем 1ИС061А	0,4 В
Предельная температура кристалла для микросхем 1ИС061А	+150°С
Тепловое сопротивление кристалл — среда для мик- росхем 1ИС061А	0,25°С/мВт

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ
И РЕЖИМОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ ○

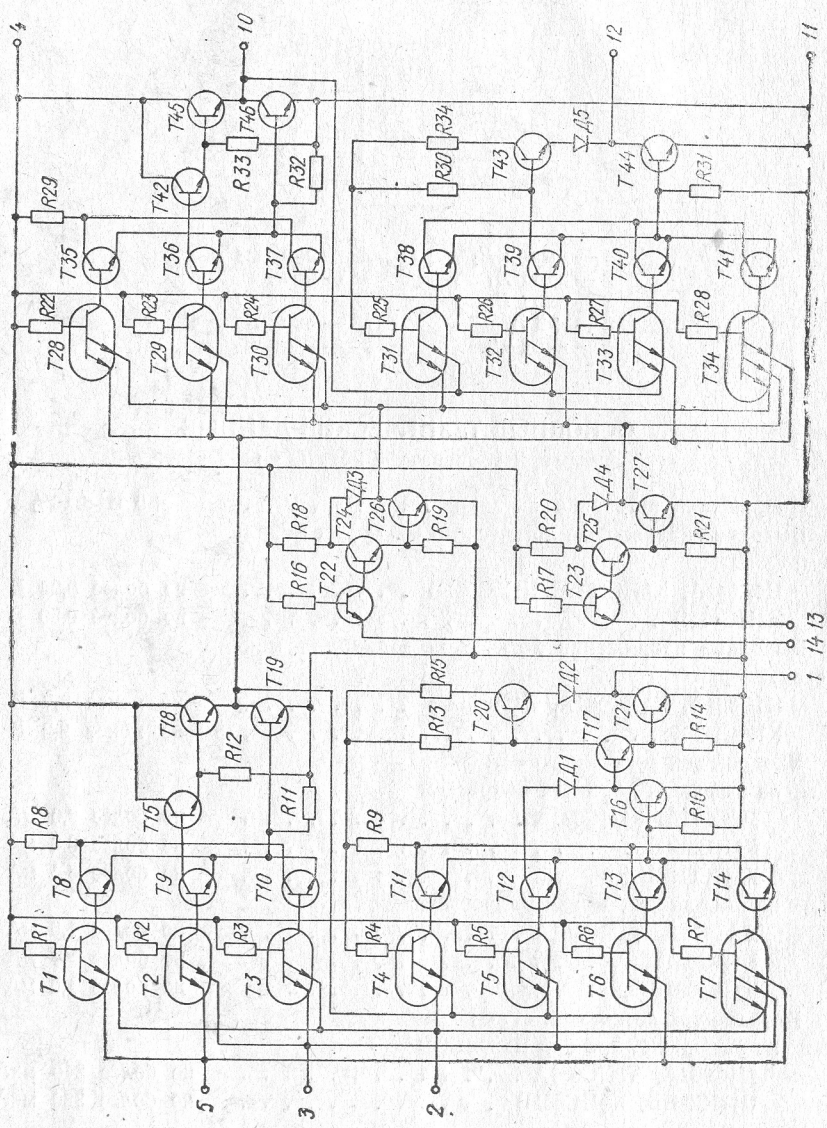
Напряжение источника питания	+6 В
Напряжение источника питания в течение 5 мс для микросхем 1ИС061А	+7 В
Постоянное напряжение на функциональных входах	+5,5 В
Отрицательное напряжение на входах	минус 0,3 В
Ток нагрузки для микросхем 1ИС061А, К1ИС061А, К1ИС061Б на выходах:	
E_1 и E_2	18 мА
C_2	9 мА
Максимальная емкость нагрузки	200 пФ
Предельная допустимая мощность, рассеиваемая на корпусе микросхемы К1ИС061В при температуре от ми- нус 45 до +25°С	0,4 Вт

○ При температуре окружающей среды, допускаемой условиями эксплуатации.

ДВУХРАЗРЯДНЫЙ СУММАТОР

К1С061А К1С061Б
 1ИС061А К1С061В

ПРИНЦИПАЛЬНАЯ СХЕМА

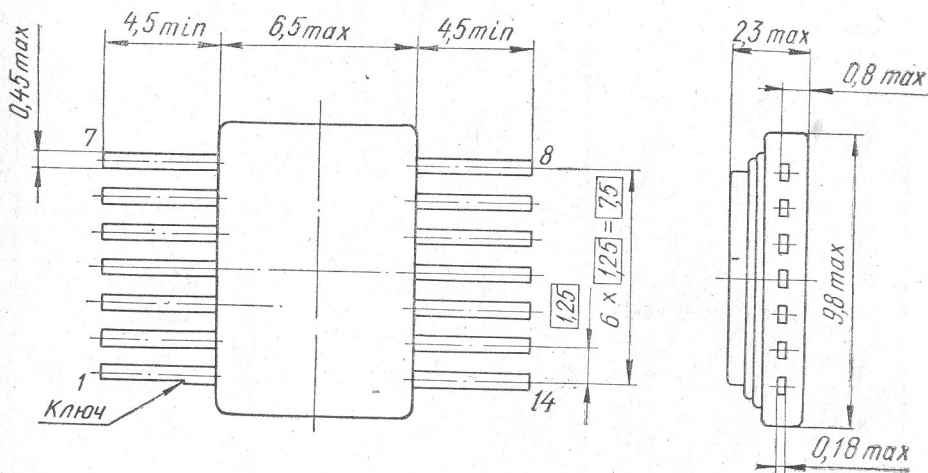


МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СЕРИИ 106 (К106)

Общие данные

Микросхемы серии 106 (К106) выполнены в прямоугольном металлоглазном корпусе.

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ
микросхем серии 106 (К106)



Масса микросхем серии:
106 — не более 0,35 г,
К106 — не более 0,5 г

МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СЕРИИ 106 (К106)

Общие данные

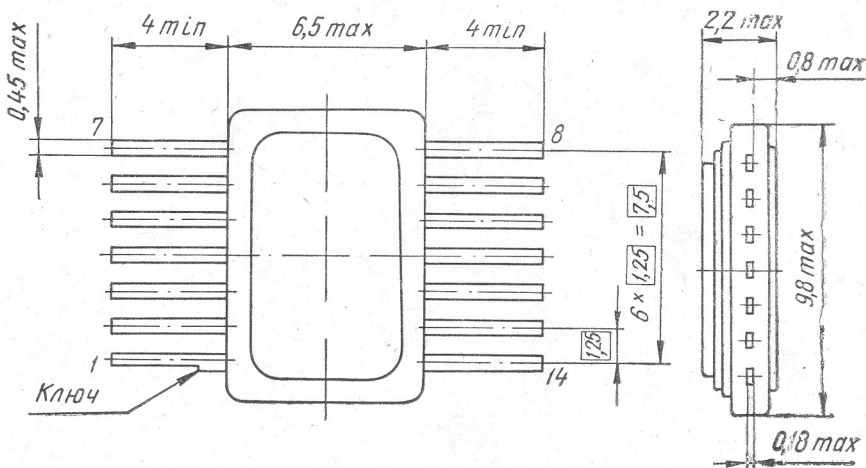
Смещение осей выводов от номинального расположения не более 0,1 мм (допуск зависимый).

Нумерация выводов показана условно.

Микросхемы серии 106-1 (К106-1), 106-2 (К106-2) выполнены в прямоугольном металлостеклянном корпусе с металлическим дном.

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

микросхем серии 106-1 (К106-1), 106-2 (К106-2)



Масса микросхем серии:

106-1, 106-2 — не более 0,35 г,

К106-1, К106-2 — не более 0,6 г

Смещение осей выводов от номинального расположения не более 0,1 мм (допуск зависимый).

Нумерация выводов показана условно.

МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СЕРИИ 106 (К106)

Общие данные

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Вибрация для микросхем серии:

106

диапазон частот от 5 до 5000 Гц
ускорение до 40 g

К106

диапазон частот от 5 до 5000 Гц
ускорение до 40 g

Одиночные удары для микросхем серии 106:

ускорение до 1000 g
длительность удара от 0,2 до 1,0 мс

Линейные нагрузки для микросхем серии:

106

ускорение до 150 g

К106

ускорение до 25 g

Температура окружающей среды для микросхем серии:

106 от минус 60 до +125° С

К106 от минус 45 до +85° С

Многократные циклические изменения температуры

для микросхем серии:

106 от минус 60 до +125° С

К106 от минус 45 до +85° С

Относительная влажность воздуха для микросхем серии 106 при температуре +40° С и серии К106 при

температуре +25° С до 98%

Для микросхем серии 106:

Атмосферное давление от 5 мм рт. ст. до 3 атм

Иней, роса.

Соляной туман.

Среда, зараженная плесневыми грибами.

НАДЕЖНОСТЬ

Минимальная наработка \circ 10 000 ч

Срок сохраняемости \circ для микросхем серии:

106 12 лет

К106 6 лет

\circ В условиях и режимах, допускаемых ОТУ, ЧТУ или ТУ.

МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СЕРИИ 106 (К106)

Общие данные

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Микросхемы следует применять и эксплуатировать в соответствии с ОСТ 11 6К0.340.010—74 и требованиями, изложенными ниже.

Перед началом монтажных и сборочных работ с микросхемами следует принять меры, исключающие появление на выводах микросхемы электростатических зарядов с величиной потенциала более 50 В, для чего тщательно заземлить на рабочем месте жало паяльника, пинцеты, металлические части стульев через сопротивление 1 МОм. Монтаж микросхем следует производить только в обесточенном состоянии.

Запрещается кручение выводов микросхем вокруг оси и изгиб в плоскости корпуса микросхемы. Изгиб выводов следует производить на расстоянии не менее 1 мм. Радиус изгиба — не менее 0,36 мм.

Микросхемы следует устанавливать на печатную плату вплотную или с зазором до 0,7 мм с последующей прилакировкой и приклейкой.

Лужение выводов следует производить двукратным погружением в расплавленный припой при температуре 250°С в течение не более 2 с, интервал между двумя погружениями — не менее 5 мин.

Пайку выводов допускается производить одножальным заземленным паяльником при температуре 265°С в течение 3 с, интервал между пайками двух соседних выводов — не менее 3 с, или групповым паяльником с температурой 265°С в течение 2 с, интервал между двумя повторными пайками — не менее 5 мин. Расстояние от корпуса до места лужения или пайки — не менее 1 мм.

После монтажа микросхемы должны быть защищены лакокрасочным покрытием, устойчивым к воздействию условий эксплуатации.

Рекомендуемое покрытие — лаки УР-231 по МРТУ 6-10-863—69 и Э-4100 по МРТУ 6-10-857—69.

Приклейку микросхем следует производить клеем АК-20 по ТУ 6-10-1293—72.